



Рис. 3. Профили распределения атомов азота после имплантации ($D_{N^+} = 5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$, $E = 40 \text{ кэВ}$):

1 – до удаления защитного оксида; 2 – после удаления защитного оксида и последующего наращивания подзатворного диэлектрика.

Проецированный пробег ионов N^+ (R_p) при имплантации с энергией 40 кэВ согласно проведенным расчетам с использованием программы SRIM составляет $\sim 110 \text{ нм}$

Fig. 3. Distribution profiles of nitrogen atoms after implantation ($D_{N^+} = 5 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-2}$, $E = 40 \text{ keV}$):

1 – before the removal of the protective oxide; 2 – removal of the protective oxide and subsequent growth of the gate dielectric.

The projected range of N^+ ions (R_p) during implantation with an energy of 40 keV according to the calculations performed using the SRIM program is $\sim 110 \text{ nm}$